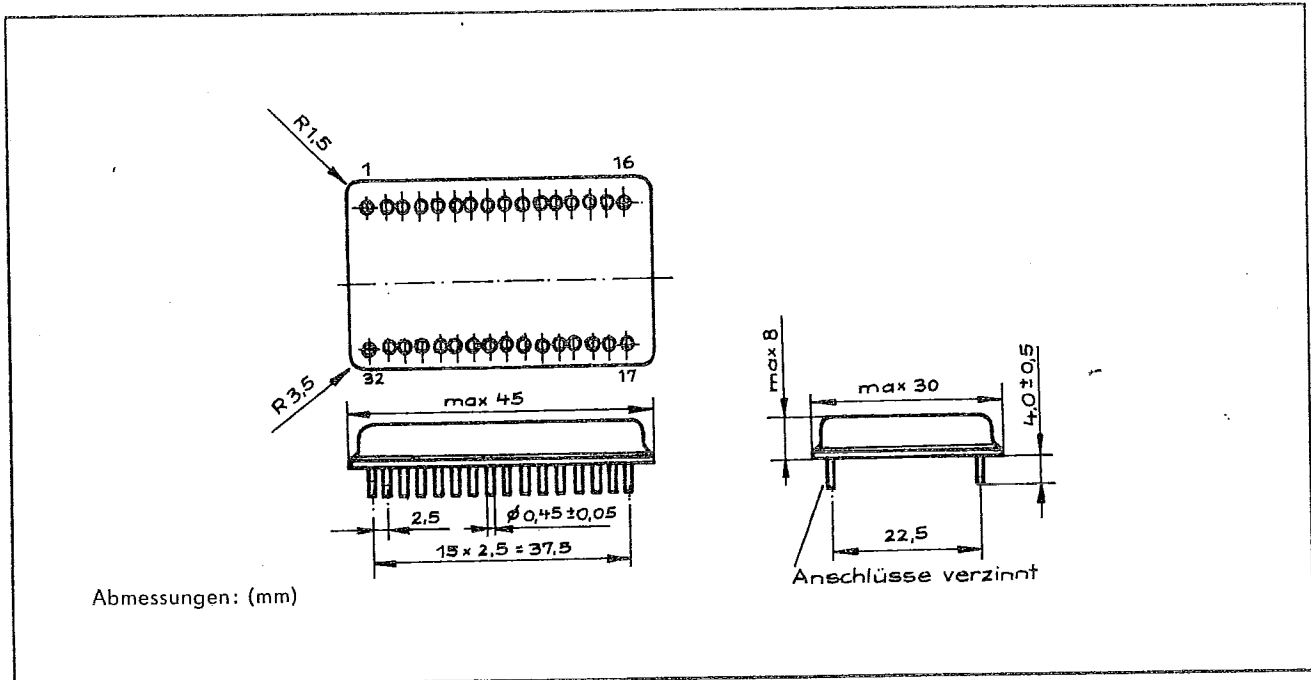


DRAM 512 Kbit-Hybridspeicher

8 M 2164

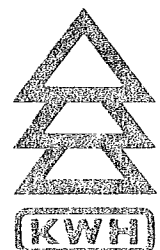
Der Hybridschaltkreis ist ein hochintegrierter dynamischer Schreib-Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Er verfügt über eine Speicherkapazität von 512 Kbit, die als Speicherblock von 64 kByte organisiert ist. Alle Ein- und Ausgänge sind TTL-kompatibel. Als Bauelemente werden die in nMOS-Techno-

logie gefertigten U 2164-Chips verwendet. Folgende Betriebsarten sind möglich; READ, WRITE, READ-MODIFY-WRITE, PACE-MODE, REFRESH. Das 32polige Hermetikgehäuse gewährleistet höchsten klimatischen und mechanischen Schutz der Schaltung.

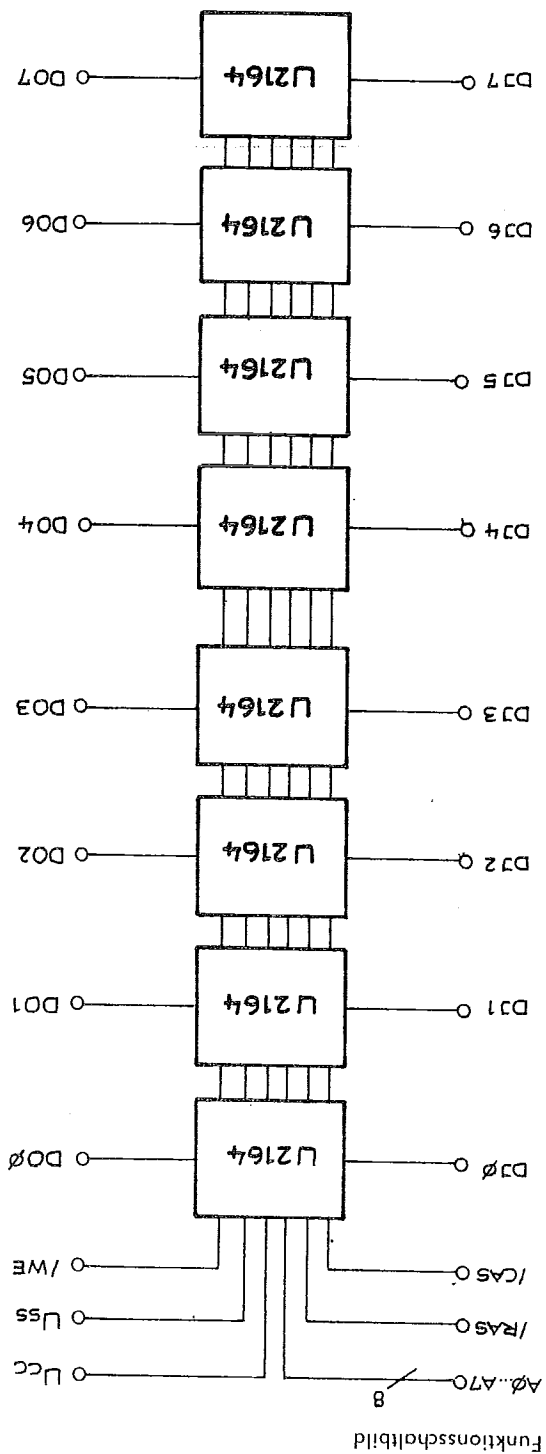


Erzeugnisnummer:	4585.8-8079.31
Typkurzzeichen:	8580
Betriebsbedingungen	
Betriebsspannung:	5 V
H-Eingangsspannung:	$\geq 2,4$ V
L-Eingangsspannung:	$\leq 0,8$ V
Betriebstemperaturbereich:	0 ... 70 °C

Kenngrößen	
Betriebsstrom:	≤ 440 mA
Ruhestrom:	≤ 40 mA
Zugriffszeit von /RAS aus:	≤ 250 ns
Zugriffszeit von /CAS aus:	≤ 150 ns



Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen für Bestellungen. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung. Änderungen und Werte vorbehalten.



Anschlußbelegung
von unten :

UCC	1	•	D00	•
A0	•	•	D01	•
A5	•	•	D02	•
A7	•	•	D03	•
A4	•	•	D04	•
/RAS	•	•	D05	•
/WE	•	•	D06	•
A2	•	•	D07	•
D03	•	•	UCC	•
A6	•	•		
/CAS	•	•		
n.c.	•	•		
A3	•	•		
Uss	•	•		
A1	•	•		
UCC	16	•		

Funktionsschaltbild